

(19)
(12)(KR)
(A)(51) 。 Int. Cl. ⁷
H05B 33/10(11)
(43)2002 - 0049877
2002 06 26(21) 10 - 2000 - 0079197
(22) 2000 12 20

(71)

575

(72)

5 109 809

955 - 1 154 1701

(74)

:

(54)

, (1) (3)
 , (5) , (5) (9)
 (11) (3) (19) (7) (11) (11)
 , (9) , (11)
 가 가 , (11) (13) Cr, Cr
 Ox, Al, MoW (15)
 , 가 , 가
 .

， ， ，

1 (OLED)

.

2 (OLED)

.

3 .

4 .

5 .

6 ,

.

7 6 , .

8 7 .

1 : 3 :

5, 15, 17 : 7 :

9 : 11 :

13 : 19 :

[]

Light Emitting Device Panel) (Organic

.

[]

(3) (pixel) (5) (1) (3) ,
 (7) . , (7) (9) ,
 (11) (1, 2).
 (5) (1) (3) (19)
 (11) (7) .
 5,773,931 5,701,055 (7) (7)
 (overhanging) (11)
 (photolithography) .
 (7) 2 ,
 (7) (11) (9)

(1) (3) ;
 (3) (19) (5) ;
 (5) (11) (7) ;
 (9) ;
 (9) (11) ;
 (11) 가 가 (13) ;
 (13) ;
 (13) (11) ;
 (15) ;
 (15) 가 (17)

가 .

3 8 .

, 3 (3) , 4 (5) .

(1) , (3) ITO, In₂O₃/SnO₂, SnO₂

/Sb, ZnO/Al 1 .

(5) SiNx, SiOx, SiC, Si, ,

1 .

, 5 , (3) (7) .

(7) SiNx, SiOx, SiC, Si 가 (sputtering method),

CVD(Chemical Vapor Deposition), PECVD, (ALD) 가 가 (spin coating)

(roll coating) .

(7) (θ) 30 90° , (7)

0.1 50 μm .

(7) SiNx, SiOx, SiC, ,

1 .

, 6 , (7) (9), (11)

. .

(11) Mg, Mg - Ag , Al - Li Sr - Mg

가 1 .

, (photolithog

raphy)가 가 .

7 , (11)

. .

(11), (9), (3) , (13)

(7) (etching rate) .

(13) (sacrificial layer) (13)

(11) 1:1 (11) ,

(13) (lithography) .

8 , SiNx, SiOx, SiC, (15)

. .

, Cr CrOx 가 (17)

. .

LD (17) (sputtering method), CVD(Chemical Vapor Deposition), PECVD, A

, 가 , 가 ,
BaO 가

(57)

1.

(1) (3) ;
(3) (19) (5) ;
(5) (11) (7) ;
(9) ;
(9) (11) ;
(11) 가 가 (13) ;
(13) ;
(13) (11) ;
(15) ;
(15) 가 (17)

2.

1 ,
(13) (sacrificial layer) (13)
(11) 1:1 (11)

3.

1 ,

(19)

1

(5) SiNx, SiOx, SiC,

,

4.

1 ,

(7) SiNx, SiOx, SiC,

,

1

5.

1 ,

(7) (θ) 30 90 °

.

6.

1 ,

(7) 0.1 50 μm

.

7.

1 ,

가 (17) Cr, Al, AlNd, MoW, TiW, CrOx

.

8.

(1);

(3);

(3)

(5);

(5)

(7);

(7)

(9);

(9)

(11);

(11)

(13);

(7),

(9),

(11)

(13)

(15)

(15)

(17)

9.

8 ,

(19)

1

(5) SiNx, SiOx, SiC,

,

10.

8 ,

(7) SiNx, SiOx, SiC,

,

1

11.

8 ,

(7) (θ) 30 90 °

12.

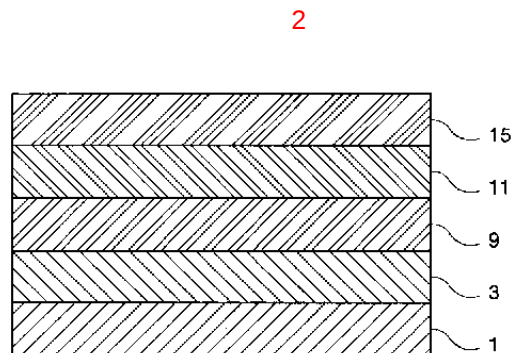
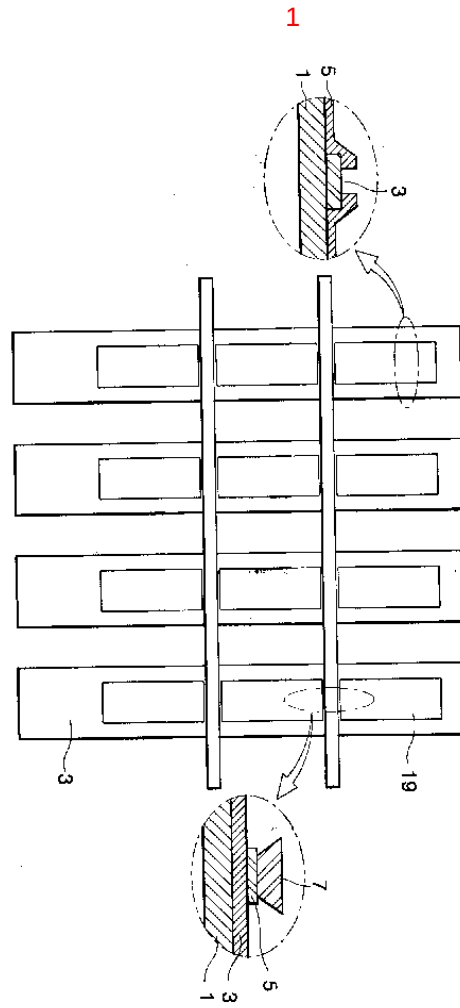
8 ,

(7) 0.1 50 μm

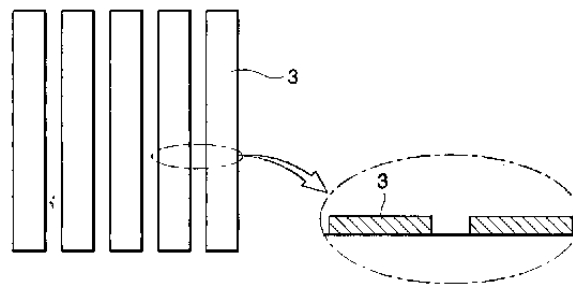
13.

8 ,

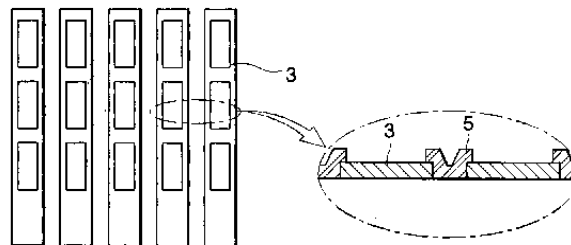
가 (17) Cr, Al, AlNd, MoW, TiW, CrOx



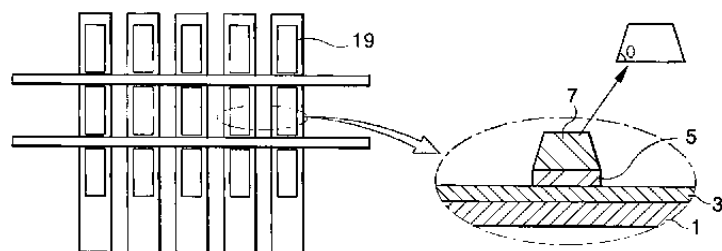
3



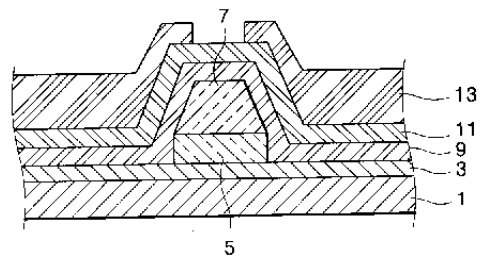
4



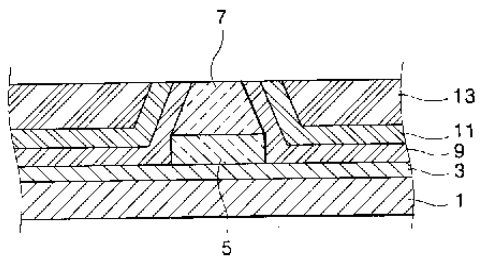
5



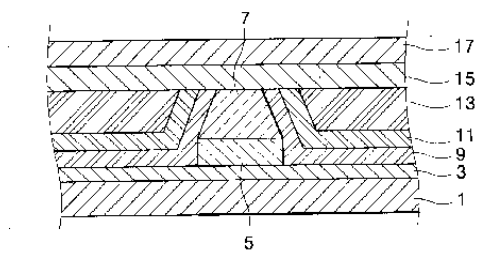
6



7



8



专利名称(译)	有机电致发光器件面板的制造方法		
公开(公告)号	KR1020020049877A	公开(公告)日	2002-06-26
申请号	KR1020000079197	申请日	2000-12-20
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	KANG TAEWOOK 강태욱 SONG BYUNGSANG 송병상		
发明人	강태욱 송병상		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	H01L51/0018 H01L51/0023 H01L51/56		
代理人(译)	PARK, 常树		
其他公开文献	KR100570991B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及有机发光器件面板的制造方法和面板。并且，因为通过提供包括在基板（1）上形成阳极（3）的步骤的有机发光装置面板的制造方法和面板而不使用反相的绝缘屏障，所以形成绝缘层的步骤（5）用于在阳极（3）上设置像素（19），在绝缘层（5）上形成用于电子注入电极（11）的电绝缘的绝缘屏障（7）的步骤，该步骤形成上述步骤之后的步骤，此后，用于辐射的有机层（9），在有机层（9）上形成电子注入电极（11）的步骤，以及光刻在上面的步骤电子注入电极（11）形成可能的材料，通过光刻材料形成图案的步骤，去除干蚀刻工艺的步骤电子注入电极（11），形成前一步骤的步骤此后，绝缘层（13）和在绝缘层（13）或绝缘层（15）上形成预定厚度的Cr，CrOx，Al，MoW等金属层的再现性问题的步骤并且可以解决故障问题用于钝化的抗湿剂和保护有机层同时面板可以具有稳定的结构是不必要的。有机电致发光器件，电子注入电极，阳极，绝缘体屏障。

